Высокая стойкость к электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного применения

Полупроводниковый Элемент Низкочастотного Диода Тип DR80-3200-36

Максимально допустимый средний прямой ток[1)]			I_{FAV}	3200 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение			U_{RRM}	3000...3600 В
U_{RRM}, В	3000	3200	3400	3600
Класс по напряжению	30	32	34	36
T_j, °C	–60...+160			

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{FAV}	Максимально допустимый средний прямой ток[1)]	А	3200 3853	T_c=114 °C; двухстороннее охлаждение; T_c=100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FRMS}	Действующий прямой ток[1)]	А	5024	T_c=114 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FSM}	Ударный ток[1)]	кА	58.0 70.0	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; t_p=10 мс; единичный импульс; U_R=0 В;
			61.0 73.0	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; t_p=8.3 мс; единичный импульс; U_R=0 В;
I^2t	Защитный показатель[1)]	$A^2c\cdot10^3$	16800 24500	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; t_p=10 мс; единичный импульс; U_R=0 В;
			15400 22100	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; t_p=8.3 мс; единичный импульс; U_R=0 В;
Блокирующие параметры					
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	3000...3600	$T_{j\,min}$< T_j <$T_{j\,max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	3100...3700	$T_{j\,min}$< T_j <$T_{j\,max}$; 180 эл. град. синус; единичный импульс	
U_R	Постоянное обратное напряжение	В	$0.6\cdot U_{RRM}$	T_j=$T_{j\,max}$	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	°C	–60...+50		
T_j	Температура p-n перехода	°C	–60...+160		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие[1)]	кН	40...50		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение[1)], макс	В	1.80	T_j=25 °C; I_{FM}=10048 A	
$U_{F(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	0.878	$T_j=T_{j\,max}$; 0.5 π I_{FAV} < I_T < 1.5 π I_{FAV}	
r_T	Динамическое сопротивление[1)], макс	мОм	0.101		
Блокирующие характеристики					
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	150	$T_j=T_{j\,max}$; $U_R=U_{RRM}$	
Тепловые характеристики					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление p-n переход-корпус[1)], макс	°C/Вт	0.0085	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R_{thjc-A}			0.0187		Охлаждение со стороны анода
R_{thjc-K}			0.0153		Охлаждение со стороны катода
Механические характеристики					
m	Масса, макс	г	201		

МАРКИРОВКА

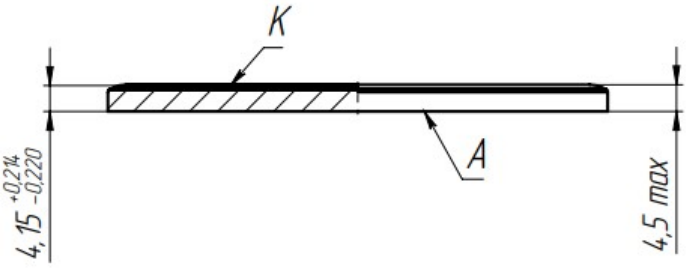
DR	80	3200	36
1	2	3	4

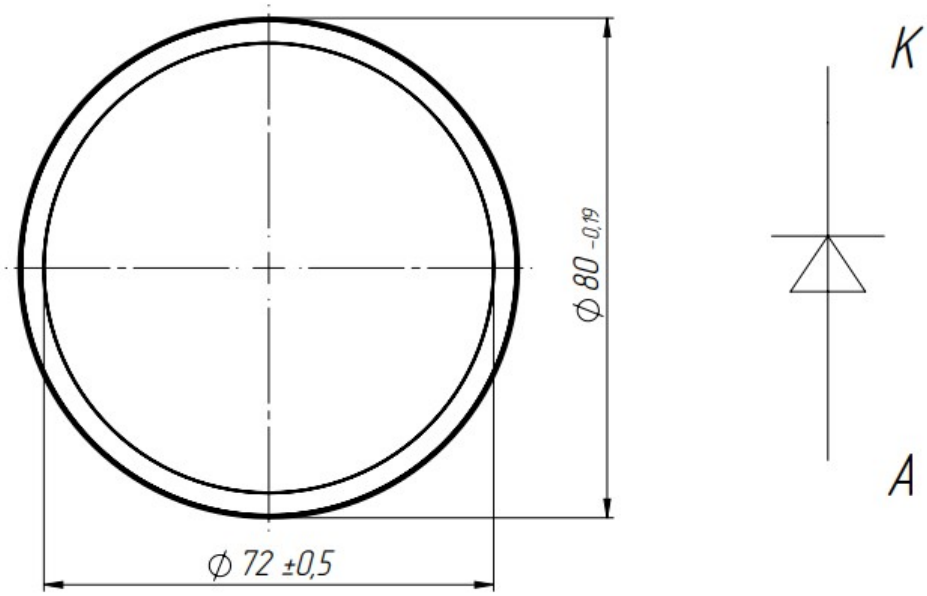
1. ППЭ Низкочастотного Диода
2. Максимальный диаметр, мм
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению

ПРИМЕЧАНИЕ

[1)] В зависимости от характеристик применяемого корпуса. Указанные значения актуальны при использовании корпуса Протон-Электротекс D.F3.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





Все размеры в миллиметрах

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.